パルス化 0.36 MeV C₆₀マイクロビームによる微小領域質量分析試験

Preliminary results of micro mass analysis using focused and pulsed 0.36 MeV C₆₀ ion beams

平田浩一 #,A), 山田圭介 B), 千葉敦也 B), 平野貴美 B), 鳴海一雅 B), 斎藤勇一 B)

K. Hirata #,A), K. Yamada B), A. Chiba B), Y. Hirano B), K. Narumi B), Y. Saitoh B)

^{A)} National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

^{B)} National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

Abstract

Micro mass analysis of a 400-mesh grid target was performed using a time-of-flight mass spectrometer combined with pulsed and focused 0.36 MeV C₆₀ ion beams, which were produced using electrostatic quadrupole triplet focusing and subsequent XY deflection systems.

Keyword: cluster, secondary ions

1. はじめに

Sub-MeV~数 MeV 領域の入射エネルギーを持つ高 速クラスターイオンの物質への照射における特徴の 一つに、入射イオン当たりに放出される2次イオン の強度が非常に高いことが挙げられる[1]。高い2次 イオン強度は、それを用いた2次イオン分析に有利 であるため、我々は、高速クラスターを1次イオン として用いた2次イオン質量分析法(高速クラスタ -2次イオン質量分析法)を開発した[2,3]。また、 各種1次イオンの中でも、クラスター数が比較的大 きく安定である C60 を sub-MeV 〜数 MeV 領域まで加速 した1次イオンを用いた、高速C602次イオン質量分 析装置を開発し[4,5]、その優位性等を報告してきた。

上記、2次イオン質量分析法を、微小領域分析、 イメージング分析等へ展開するためには、マイクロ ビーク化やそのパルス化を含む高速 C60 照射技術の 高度化が必要になる。今回は、パルス化した高速 C60 マイクロビームを用いて、微小領域の2次イオン質 量分析を行ったので、結果の一部を報告する。

2. 実験

TIARAの400 kVイオン注入器のビームラインに、 ビーム集束用の静電型3連四重極レンズ系、及び、 その下流に、集束したイオンビームを電場により偏 向させることで任意の位置に照射させるための特定 位置照射システム系を設置した。これらの集束レン ズ・照射システム系により、集束したイオンビーム を、試料上の特定位置に照射することができる。

イオン照射により試料から放出した2次イオンは、 試料に正対する形で設置された飛行時間型質量分析 器の末端に設置したマイクロチャネルプレートによ り検出され、特定位置照射システム系の制御信号と 2次イオン検出信号を関連付けすることで2次イオ ン像を得ることができる。さらに、入射ビームをパ ルス化することで、2次イオン質量分析を行うこと も可能である。

3. 結果と考察

図1に、集束した0.36 MeV C₆₀+ビームを走査させ ることで得られた、400 メッシュ試料の正2次イオ ン検出像を示す。メッシュ試料の構造が確認できる。 また、2次イオン像中の印を付けた部分の正2次イ オン質量分析スペクトルも示す。スペクトルには、 メッシュ試料の成分である Cu⁺ (m/z = 63, 65)の 他、Na⁺ (m/z = 23) 、K⁺ (m/z = 39) 、SiC₃H₉⁺ (m/z= 73) 、 $Si_2C_5H_{15}O^+$ (m/z = 147) 等のメッシュ表面の 付着物由来の2次イオンも観測された。このように、 0.36 MeV C₆₀⁺ビームを用いて微小領域の2次イオン 質量分析を行うことができた。

4. 謝辞

本研究の一部は、科研費「高感度顕微分析を実現 する高速クラスター2次イオン質量分析における照 射技術の高度化」[基盤研究(B)(一般)](17H02819) によって行われた。



Figure 1 Positive secondary ion (P-SI) image of a 400-mesh grid for 0.36-MeV C60⁺ and P-SI TOF mass spectrum at the marked point in the image.

参考文献

- [1] K. Hirata et al., Appl. Phys. Lett., 81 (2002) 3669.
- [2] K. Hirata et al., Appl. Phys. Lett., 83 (2003) 4872.
- [3] K. Hirata et al., Appl. Phys. Lett., 86 (2005) 044105.
- [4] K. Hirata et al., Nucl. Instr. and Meth. B 266 (2008) 2450.
- [5] K. Hirata et al., Rev. Sci. Instrum., 85 (2014) 033107.

k.hirata@aist.go.jp